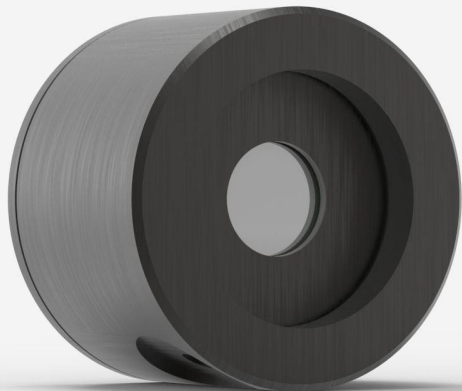


## PE10B-SI-D0

최대 81 nJ의 레이저 에너지 계측용 광전다이오드 검출기.



### 제품군 주요 특징

#### VERY LOW NOISE LEVEL

Take measurements with a noise level as low as 8 fJ (model PE3B-Si only) with the M-LINK, MAESTRO and S-LINK monitors.

#### 3 SENSORS AVAILABLE

- PE-B-SI family: 3 and 10 mm Ø silicon sensors for 0.21 to 1.08 µm
- PE5B-GE: 5 mm Ø, germanium sensor for 0.8 to 1.65 µm
- PE3B-IN: 3 mm Ø, InGaAs sensor for 0.9 to 1.7 µm

#### SMART INTERFACE

Containing all the calibration data

#### 호환 스탠드

STAND-D-233

## 사양

### 계측 성능

스펙트럼 범위 <sup>1</sup>	210 - 1080 nm
일반 상승 시간	30 µs
최대 반복 주파수	1000 Hz
최대 계측가능 에너지 <sup>2</sup>	81 nJ
등가노이즈에너지 <sup>3</sup>	1.5 pJ
최대 펄스폭	10 µs
에너지 교정 불확정성	±18 % (210 - 229 nm) ±8.0 % (230 - 254 nm) ±6.5 % (255 - 399 nm) ±2.5 % (400 - 899 nm) ±4.0 % (900 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm)

1. 이 검출기는 634nm의 교정 파장에서 NIST 추적이 가능합니다. 일반적인 값은 다른 파장에서 사용됩니다.

2. 634nm. 다른 파장에서의 최대 출력 곡선을 참조하십시오.

3. 액면 값. 실제 값은 환경의 전자파 간섭 및 파장에 따라 달라집니다.

### 손상 한계

최대 평균 파워 밀도	65 mW/cm <sup>2</sup>
최대 에너지 밀도	5 µJ/cm <sup>2</sup>
최대 파워	230 µW

### 물리적 특성

구경 지름	10 mm
업소버	SiUV
치수	38.1Ø x 27.4D mm
중량	0.09 kg
센서면까지의 거리	13.7 mm

### 주문 정보

PE10B-SI-D0	202019
PE10B-SI-IDR-D0	

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

## 이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

[gentec-eo.com/ko/contact-us](http://gentec-eo.com/ko/contact-us)에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.